

Silicon Diode

BA100

60V / 90mA

DATASHEET

OEM – Valvo

Source: Valvo Halbleiterdioden und Transistoren1969-70

Datasheet Rev. 1.0 – 07/20 – data without warranty / liability

NICHT FÜR NEUENTWICKLUNGEN

BA 100

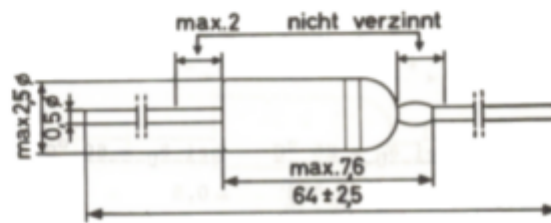
SILIZIUM - FLÄCHENDIODE
Allzweckdiode

Mechanische Daten:

Gehäuse: Allglas, DO-7

Farbring: Katodenseite

Maßangaben in mm.



Kurzdaten:

Sperrspannung	U_R = max. 60 V
Durchlaßstrom bei $\vartheta_U = 25\text{ }^\circ\text{C}$	I_F = max. 90 mA
Durchlaßstrom, Scheitelwert	I_{FM} = max. 100 mA
Umgebungstemperatur	ϑ_U = max. 90 °C
Durchlaßspannung bei $I_F = 10\text{ mA}$, $\vartheta_U = 25\text{ }^\circ\text{C}$	U_F = 0,8 V
Sperrstrom bei $U_R = 60\text{ V}$, $\vartheta_U = 75\text{ }^\circ\text{C}$	I_R = 20 μA

BA 100 NICHT FÜR NEUENTWICKLUNGEN

Absolute Grenzwerte: (gültig bis $\vartheta_U \text{ max}$)

Sperrspannung:	U_R	= max. 60 V
Durchlaßstrom bei $\vartheta_U = 25 \text{ }^\circ\text{C}$:	I_F	= max. 90 mA
Durchlaßstrom, Scheitelwert:	$I_{F M}$	= max. 100 mA
Überlastungs-Stromstoß:	$i_{F \text{ stoß}}$	= max. 200 mA
Umgebungstemperatur:	ϑ_U	= min. $-55 \text{ }^\circ\text{C}$
	ϑ_U	= max. $90 \text{ }^\circ\text{C}$
Lagerungstemperatur:	ϑ_S	= min. $-55 \text{ }^\circ\text{C}$
	ϑ_S	= max. $90 \text{ }^\circ\text{C}$

Wärmewiderstand:

Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: $R_{th U} \lesssim 0,4 \text{ grd/mW}$

Kennwerte:

Durchlaßspannung	bei $\vartheta_U = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	bei $\vartheta_U = 60 \text{ }^\circ\text{C}$	bei $\vartheta_U = 75 \text{ }^\circ\text{C}$
bei $I_F = 0,1 \text{ mA}$:	$U_F = 0,55 (\lesssim 0,75)$	0,5	V
bei $I_F = 1 \text{ mA}$:	$U_F = 0,65 (0,5 \dots 1)$	0,6 (0,4...0,9)	V
bei $I_F = 30 \text{ mA}$:	$U_F = 0,90 (\lesssim 1,5)$	0,85 ($\lesssim 1,5$)	V
Sperrstrom			
bei $U_R = 10 \text{ V}$:	$I_R \lesssim$	5	10 μA
bei $U_R = 60 \text{ V}$:	$I_R \lesssim$	10	20 μA